

(11)Publication number:

64-053504

(43)Date of publication of application: 01.03.1989

(51)Int.CI.

H01C 7/13 H01C 13/00

(21)Application number: 62-210493

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

25.08.1987

(72)Inventor:

**HOSOKAWA ZENEMON** 

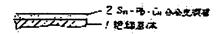
SHINDO YASUHIRO

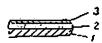
### (54) OVERLOAD FUSIBLE RESISTOR

### (57)Abstract:

PURPOSE: To make the tille resistor to be fused quickly by self-heating of a resistive film itself by a method wherein an Sn-Pb-Ni alloy film layer containing a specific range of Ni is provided on the surface of an insulating substrate, a thermosoftening resin layer to cover one part or a whole part of the resistive film is formed and this assembly is covered completely with an insulator such as a thermally contractive tube or the like.

CONSTITUTION: An Sn-Pb-Ni alloy film layer 2 to be formed on an insulating substrate 1 contains about 0.1W50wt.%, preferably 6W20wt.%, of Ni with reference to the weight of the Sn-Pb-Ni alloy film. Caps 4 are pressure-capped on a resistive film composed of the Sn-Pb-Cu alloy film layer 2 at both ends of the insulating substrate 1; lead wires 5 are welded to the caps; a grooved part 7 which has been formed by cutting a groove is formed on an circumferential face; fusion of the resistive film which is softened due to heat generated at an overload and which is melted due to a drop in viscosity and a flux action is promoted. Lastly, the whole part of the resistor is covered with a protective layer 6 composed of an insulator, e.g. a thermally contractive tube; an overload- fusible resistor is completed.







# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

① 特許出 顧公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-53504

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和64年(1989)3月1日

H 01 C 13/00 7048-5E F-7303-5E

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

の発明の名称

過負荷溶断形抵抗器

頭 昭62-210493 到特

願 昭62(1987)8月25日 図出

細川 @発 .明 者 明 者 進 四発

善右ェ門 宏

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

①出 頭 人

藤 松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 中尾 敏男

外1名

1、発明の名称

遇負荷溶断形抵抗器

- 2、特許請求の範囲
- (1) 絶録基体表面に、Ni を O. 1~50 Wt%の範 囲で含むSn-Pb-Ni合金皮膜層を備え、抵抗 皮膜の一部分または全体を覆うように熱軟化性 樹脂層が形成され、かつ全体が熱収縮チューブ 等の絶録物で覆われた過負荷溶断形抵抗器。
- (2) Sn-Pb-Ni合金皮膜層に抵抗値修正用の溝 切りを設け、その帯切り中央部を含む抵抗皮膜 の一部分または全体を覆うように熱軟化性樹脂 層を形成した特許請求の範囲第1項配載の過負 荷密断形抵抗器。
- (3) 絶縁基体表面に Ki を 0.1~ 50 \*\* t % の範囲 ·で含むSn-Pb-Ni合金皮膜層を設け、これら を熱処理してなる合金抵抗皮膜を備え、合金抵 抗皮膜の一部分または全体を覆うように熱軟化 性樹脂層が形成され、かつ全体が熱収縮チュー プ等の絶機物で覆われた過食荷溶断形抵抗器。

- (4) Sn-Pb-Ni合金皮膜層に抵抗値修正用の溶 切りを設け、その得切り中央部を含む抵抗皮膜 の一部分または全体を覆りように熱軟化性樹脂 局が形成した特許請求の範囲第3項記載の過負 荷帑断形抵抗器。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は民生用機器,産業用機器等に広く使わ れている過負荷溶断形抵抗器に関するものである。 その目的は過電流が流れた時に抵抗皮膜自体の自 己発熱により速やかに溶断するものを提供すると とにある。

従来の技術

最近、機器の軽薄短小化低電力化の要請に伴い、 過負荷裕断形抵抗器には、異常時における印加電 力が定格電力に対し低倍率であっても、電流を遮 断できるととが要求されている。従来、との種の 過負荷溶断形抵抗器には、

(1) 金属皮膜、金属酸化物皮膜またはカーポン皮 腹等の一般抵抗皮膜上に低融点ガラスペースト

# 特開昭64-53504(2)

を塗布したもの。

- (2) 抵抗皮膜とそれを支持或いは保護している材 料の熱膨張係数の差を利用したもの。
- (2) 部分的に電流通路を狭くして熱染中化を起こ し溶断させるもの。
- (4) 溶断形抵抗皮膜を使用するもの、等がある。 発明が解決しようとする問題点

しかし、とれらの従来の抵抗器にあっては、定格電力の例えば4~5倍程度の低倍率で溶断させることは一般に困難である。とのため、上配(4)のタイプの抵抗器において改良が試みられており、定格電力の4~5倍の低倍率の印加電力で溶断するものも開発されているが、抵抗皮膜材料の溶断温度が低くなりすぎ、はんだ付・取付時等の外部からの熱により溶断することがあるという問題点を有する。

本発明は過電流が流れた時に抵抗皮膜自体の自己発熱により速やかに溶断するものを提供するととを目的とする。

問題点を解決するための手段

ない。

- 実施例

以下本発明の実施例を示す添付図面を参照しつ つ本発明を説明する。

第1図は、本発明の一実施例に係る抵抗器の一部を示す断面図である。まず第1図において1は 絶縁基体であって、これはこの分野で通常使用されている磁器等の材料から成る。その寸法形状は、 目的とする抵抗器の定格電力等により適宜決定されるが、典型的には例えば直径1.7~4.5mm、長さ5.5~14.0mmの円柱状磁器が例示される。かかる絶縁基体は常法に従い祖化、脱脂等の通常行なわれる処理を施して使用する。

本発明の一実施例においては、前記 Sn-Pb-N1 合金皮膜層を設けるに当り、活性化処理・下地処理の後、電気メッキ法により設ける方法がある。 またこのような虚式法の代わりに蒸着法・スパッ タリング法・気相めっき法・イオンめっき法等も 考えられる。

とのSn-Pb-Ni 合金皮膜障 2 は Sn-Pb-Ni

これら問題点を解消すべく、本発明は、絶縁基件表面に、N1をO.1~50Wt %の範囲で含むSn-Pb-N1合金皮膜層を備え、抵抗皮膜の一部分または全体を要りように熱軟化性樹脂層が形成され、かつ全体が熱収縮チューブ等の絶縁物で整われた過負荷溶断形抵抗器を提供するものである。

合金皮膜重量化対し、NiをO.1~60mt%程度、 好ましくは6~20 Wt%程度含有しており、残部 Sn 及びPb からなるものであって、Sn とPb との割合は、Sn 98~10 wt%に対しPb 2~ 9 O Wt%、好ましくは、 Sn BO~ 4 O Wt%に対 してPD 20~60 Wt%、より好せしくはSnee~ 5 5 Wt % に対して Pb 3 5 ~ 4 5 Wt % である。上記 Ni 含量が 0.1 wt% を下回る場合は、Sn-Pb-Ni 合金皮膜層の溶断温度を上昇させ外部からの 熱に対する耐性を向上させるのに充分ではたい場 合が多く、一方 Ni 含量を50 Wt%以上とする ことは通常条件的に安定性に欠ける点で好ましく ない。 Sn-Pb-Co合金皮胶層 2の厚さは目的と する抵抗器の形状定格電力等によっても変わり得 るが、通常は抵抗値で10~120 mΩ 程度の範 囲とすればよい。

セラミック上に形成された合金抵抗皮质はそのまま使用してもよいが、更に抵抗皮膜を熱処部により合金化した場合にも所室の効果が発揮される ことを見出した。しかも、との合金化を行たうと

# 特開昭64-53504 (3)

とにより、本抵抗器製造工程における加熱等に対する抵抗値変化が少なくなるという効果も発揮される。上配熱処理は温度140~200℃程度で3~24時間程度を要して行なわれる。とうして絶殺基体上に熱処理により形成された合金層が設けられた構造が得られる。

以上のようにして得られた合金抵抗皮膜には必要に応じ、抵抗値修正用の微切りが行なわれる。

次に本発明では軟化性御脂層を、滞切りを施し 又は施さない抵抗膜の一部の範囲又は全範囲に形 成する。

第2図は、第1図のSn-Pb-Cuの合金皮膜層 2上に熱軟化性樹脂層3が形成されている状態を 示すものである。

第3図は、第2図の8n-Pb-Cu合金皮膜暦2からたる抵抗皮膜上に、絶縁基体1の両端にかいてキャップ4を圧入し、これにリード線6を溶接したもので、上配合金皮膜暦2の周面には毒切りにより形成された海切り部でが設けられている。その毒切り中央部(即ち、海切りを施された部分

分野で慣用されている絶縁物からなる保護層 6、 例えば熱収縮チューブ等で覆うととにより、過負 荷溶断形抵抗器が完成する。

本発明のそれぞれの過負荷溶断形抵抗器は、いずれも定格電力の4~5倍程度の低電力倍率で安定かつ信頼性高く溶断し、電流を遮断するものである。その溶断機構は未だ完全に解明されていたいが、かそらく本発明の抵抗皮膜(Sn-Pb-Ni合金皮膜)は比較的低融点であり、抵抗皮膜の監点に違すると、上配抵抗皮膜が融解し、また同時に熱軟化性樹脂層の熱軟化による粘度の低下及びフラックス作用が相俟って、融解した抵抗皮膜は表面張力により球状化し、こりして溶断が達成されるものと推察される。

次に、具体的実施例を掲げて、本発明を更に許 しく説明する。

径 1.7 mm、長さ 6.6 mmの 時子 化スパッタリング 法にて 着腹を施し、抵抗値 6 O m Ω の過負荷溶断 形抵抗器を得た。なおこの S n - P b - N i 皮膜中に の中央部)の一部分に、前記熱軟化性樹脂層 3 が 設けられている。

上記熱軟化性樹脂層3は、過負荷時の発熱によ り軟化し、粘度の低下及びフラックス作用により、 溶融した抵抗皮膜の溶断を助長するものであり、 例えば、ロジンオレフィン系、スチレン系、ナイ ロン系,フェノール系,キシレン系の樹脂及びと れらの変性品等の熱軟化性樹脂が例示できる。と れら熱軟化樹脂は、抵抗皮膜の溶断時の温度付近 (一般に90~260で程度)にて軟化し、粘度 が低下するものが好ましく、特に溶融した抵抗皮 膜が表面張力により球状化することを助ける作用 を有するものがより好せしい。熱駄化性樹脂層3 の厚さは使用する樹脂の種類等によっても変わり 得るが、一般に2~20年 程度、好ましくは 5~1 5 A B 程度とすればよい。かかる熱軟化性 樹脂層3は熱軟化性樹脂の溶液又は融解物を築状 のもので逸布するか、浸渍法又は印刷方式で形成

最後に第3図に示すように、抵抗器全体をこの

含まれるNi は15.7 選量%であった。

その皮膜の鉛筋硬度を熱処理前及び170℃3 時間の熱処理後において測定したところ、熱処理 前は4月相当で、熱処理後の従来品にほぼ相当す るのに対し、熱処理後は6日相当であった。尚、 **鉛盤硬度の測定方法は次の通りである。即ち、抵** 抗体表面に対し40~60℃の角度で規定の硬度 を有する鉛鏃(E~9H)で抵抗体表面をとすり、 傷の有無を観察し傷がなく単に鉛筆の跡のみが幾 る最高の鉛筆硬度でもって皮膜の硬度を評価する。 上配実施例で得られた本発明の過負荷溶断形抵抗 器の密断特性を試験した。試験方法は次のとおり である。第4図に示す回路にて試験を行ない、電 源は定電圧電源を使用するものとする。第4図に おいてR, は試験抵抗器である。R2 は高電力・ 安定抵抗器であり、その抵抗値はR, の30~50 倍とし、R、にシリーズ接続しておく。あらかじ め、試験抵抗器R、の代わりに高電力ダミー抵抗 器を使用し、溶断特性仕様に定められた条件にな るように電原の電圧をあわせておく。次化ダミー

# 特開昭64-53504.(4)

抵抗の代わりに試験する抵抗器を取り付けスイッナ 8 を入れる。スイッチを入れてから規定の電流・が流れているか電流計で確認し、規定の電流化なっていない場合、すみやかに(1 秒以内)微調整を行なり。ただし、それ以降は電源の調整は行なわない。スイッチを入れてから断線するまでの時間を測定する。抵抗器の断線状態に至ったことの判定は、電流値が最初の試験電流の1/60になった状態をもって行なり。この結果を第8図に示す。 希明の効果

本発明の抵抗器は、定格動作時には、一般の抵抗器と同等の性能、信頼性を有する過負荷溶断形 抵抗器となる。

また、本発明の抵抗器の抵抗皮膜は、はんだ取付時等のリード線からの熱伝導等の外部からの熱 に対しては安定した耐性を示す。しかも、抵抗皮 膜硬度が高いので、製造工程における設備との接 触等の外力による傷がつきにくいという利点もあ る。加えて、抵抗皮膜上に熱軟化性樹脂層が形成 されているので、溶断特性が高く、溶断後の耐電 圧も大きいものである。また従来の皮膜抵抗器の 製造工程をそのまま活用できるため、製造コスト も低く有利である。

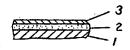
## 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例に係る抵抗器の一部 を示す断面図、第2図は第1図の抵抗皮膜上に熱 軟化性樹脂層を形成後の断面図、第3図は絶縁物 で被疑し完成した本発明の抵抗器の要部断面図、 第4図は溶断特性側定用の回路図、第6図はこれ を用いて測定された抵抗体の容断特性図である。

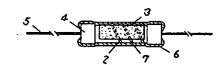
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 図

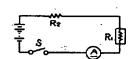
第 2 図



第 3 図



郑 4 図



# 5 図

